

Information



SU 178,179

2/84

Hersteller: VEB Mikroelektronik „Karl Liebknecht“ Stahnsdorf

Si-npn-Leistungsschalttransistor für Schaltnetzteile

Maße in mm und Anschlußbelegung

Masse ca. 22 g

Kollektor am

Gehäuse

Grenzwerte, gültig für den Betriebstemperaturbereich

Kollektor-Basis-Spannung $I_E = 0$	U_{CBO}	SU 178 800	SU 179 1000	V
Kollektor-Emitter-Spannung $I_B = 0$	U_{CEO}	400	450	V
Kollektorstrom	I_C	6		A
Kollektorspitzenstrom	I_{CM}	8		A
Gesamtverlustleistung $\vartheta_c = 50^\circ\text{C}$	P_{tot}	60		W
Sperrschichttemperatur	ϑ_j	+150		$^\circ\text{C}$

Kennwerte, ($\vartheta_c = 25^\circ\text{C} - 5\text{ K}$)

	min.	typ	max.
Kollektor-Emitter-Reststrom $U_{CE} = U_{CBO}, U_{BE} = -2\text{ V}$	I_{CEX}		1,0 mA
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung $I_C = 2,5\text{ A}, I_B = 0,5\text{ A}$	U_{CEsat}		1,5 V
Basis-Emitter-Sättigungsspannung $I_C = 2,5\text{ A}, I_B = 0,5\text{ A}$	U_{BEsat}		1,4 V
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung $I_C = 100\text{ mA}$	$U_{(BR)CEO}$	400) ¹ 450) ²	V V V
Emitter-Basis-Durchbruchspannung $I_E = 10\text{ mA}$	$U_{(BR)EBO}$	6,0	V
Abfallzeit des Kollektorstromes $I_C = 2,5\text{ A}, I_B = 0,5\text{ A},$ $- I_B = 1,0\text{ A}$	t_f		1,0 μs
) ¹ SU 178			
) ² SU 179			

Bestellbezeichnung: Transistor SU 178
Transistor SU 179

Änderungen vorbehalten!

BE-Nr. SU 178: 137 82 14 106 178006
SU 179: 137 82 14 106 179084

Die vorliegenden Datenblätter dienen ausschließlich der Information! Es können daraus keine Liefermöglichkeiten oder Produktionsverbindlichkeiten abgeleitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts sind vorbehalten.

RFT

Herausgeber:
Veb Applikationszentrum Elektronik Berlin
Im Veb Kombinat Mikroelektronik

DDR-1035 Berlin, Mainzer Straße 25
Telefon: 5 80 05 21, Telex: 011 2981 011 3055

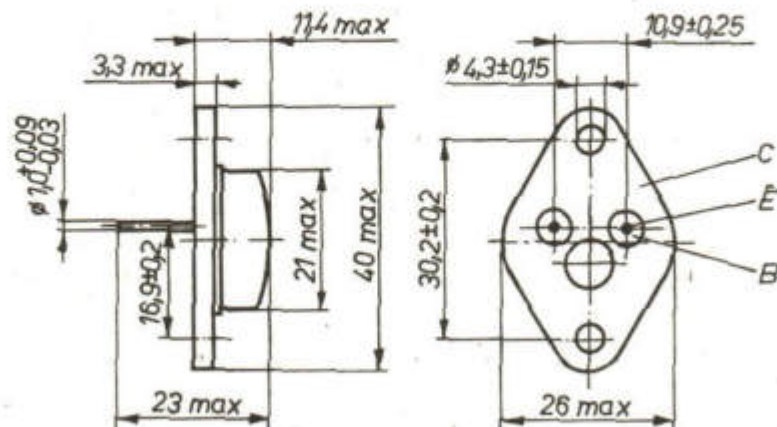
SU 178/179 / BUX 82 / BUX 83

n-p-n Si-power switching transistors for switched mode power supplies

Dimensions in mm and terminals

weight c. 22 g

Collector at case



Maximum ratings ($\vartheta_a = -25 \dots +125^\circ\text{C}$)

Collector-base-voltage

$I_E = 0$

U_{CBO}

SU 178

800

SU 179

1000 V

Collector-emitter voltage

$I_B = 0$

U_{CEO}

400

450 V

Collector current

I_C

6

A

Peak collector current

I_{CM}

8

A

Total power dissipation

$\vartheta_c \leq 25^\circ\text{C}$

P_{tot}

60

W

Junction temperature

ϑ_j

+150

$^\circ\text{C}$

Characteristics ($\vartheta_c = 25^\circ\text{C} - 5\text{ K}$)

		min.	typ	max.
Collector-emitter cut-off current $U_{CE} = 800\text{ V}, 1000\text{ V}$ (SU 178) (SU 179)	I_{CEX}			1,0 mA
Collector-emitter saturation voltage $I_C = 2,5\text{ A}, I_B = 0,5\text{ A}$	U_{CEsat}			1,5 V
Base-emitter saturation voltage $I_C = 2,5\text{ A}, I_B = 0,5\text{ A}$	U_{BEsat}			1,4 V
Collector-emitter breakdown voltage $I_C = 100\text{ mA}$	$U_{(BR)CEO}$	400 ¹⁾ 450 ²⁾		V
Emitter-base breakdown voltage $I_E = 10\text{ mA}$	$U_{(BR)EBO}$	6		V
Fall time $I_C = 2,5\text{ A}, I_B = -I_B = 0,5\text{ A}$	t_f			1,0 μs

¹⁾ SU 178

²⁾ SU 179

Denotation for ordering: Transistor SU 178
Transistor SU 179

Alteration reserved!

Ag 05/033/83



veb gleichrichterwerk stahnsdorf
im veb kombinat mikroelektronik

DDR - 1533 Stahnsdorf, Ruhlsdorfer Weg
Telefon 6 80 - Telex 015 220

elektronik
export-import

Volkseigener Außenhandelsbetrieb der
Deutschen Demokratischen Republik
DDR - 1026 Berlin, Alexanderplatz 6
Haus der Elektroindustrie, Telefon: 2180